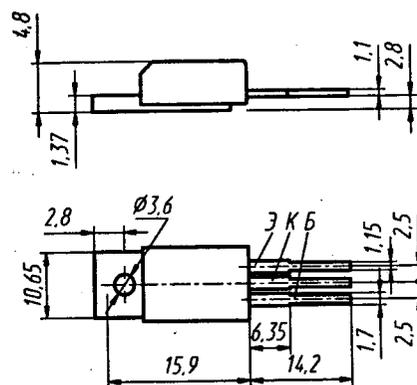


КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г

КТ829(А-Г)



Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* составные усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2 г.

Изготовитель — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 3$ В, $I_k = 3$ А, не менее:

$T_k = +25...+85$ °С	750
$T_k = -40$ °С	100

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кз} = 3$ В, $I_k = 3$ А, $f = 10$ МГц, не менее

0,4

Граничное напряжение при $I_k = 100$ мА, не менее:

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 3,5$ А, $I_b = 14$ мА, не более

2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 3,5$ А, $I_b = 14$ мА, не более

2,5 В

Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{кз R} = U_{кз R, \text{МАКС}}$, $R_{бэ} \leq 1$ кОм, не более:

$T_k = +25$ и -40 °С	1,5 мА
$T_k = +85$ °С	3 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 5$ В, не более

2 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = U_{кб, \text{МАКС}}$, не более

120 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} \leq 1$ кОм, постоянное напряжение коллектор—база:

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 500$ мкс, $Q \geq 10$

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_k = -40...+25$ °С

Тепловое сопротивление переход—корпус

Температура р-п перехода

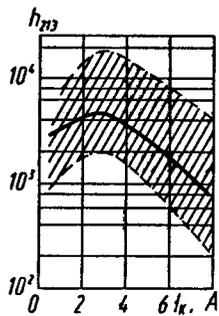
Температура окружающей среды

8 А
0,2 А
60 Вт
2,08 °С/Вт
+150 °С
-40... $T_k =$ +85 °С

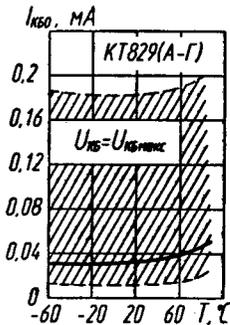
¹ При $T_k = +25...+85$ °С $P_{к, макс}$ рассчитывается по формуле

$$P_{к, макс} = (150 - T_k) / 2,08, \text{ Вт.}$$

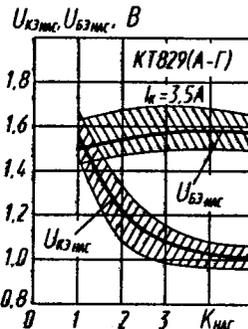
Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать +85 °С.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

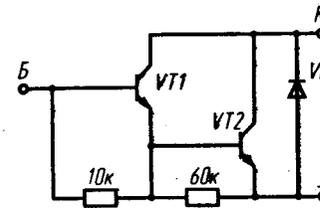


Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры

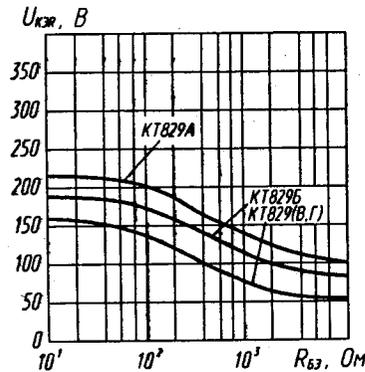


Зона возможных положений зависимостей напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от коэффициента насыщения

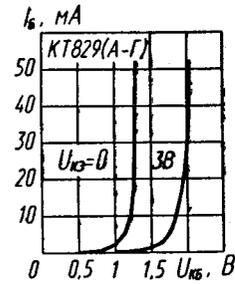
КТ829(А-Г)



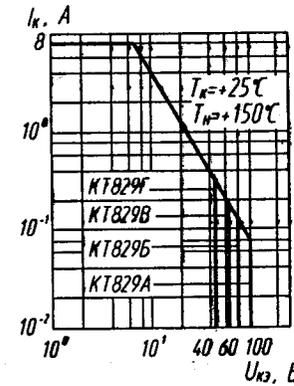
Электрическая схема транзистора



Зависимости постоянного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Входные характеристики



Области максимальных режимов